## 74HC573

# 八进制 3 态非反转透明锁存器 74HC573

#### 高性能硅门 CMOS 器件

SL74HC573 跟 LS/AL573 的管脚一样。器件的输入是和标准 CMOS 输出兼容的;加上拉电阻,他们能和 LS/ALSTTL 输出兼容。

当锁存使能端为高时,这些器件的锁存对于数据是透明的(也就是说输出同步)。当锁存使能变低时,符合建立时间和保持时间的数据会被锁存。

- ×输出能直接接到 CMOS, NMOS 和 TTL 接口上
- ×操作电压范围: 2.0V~6.0V
- ×低输入电流: 1.0uA
- ×CMOS 器件的高噪声抵抗特性

#### 管腿安排:

#### 功能表:

7111011			
	输入		输出
输出使能	锁存使能	D	Q
L	Н	Н	Н
L	Н	L	L
L	L	X	不变
Н	X	X	Z

X=不用关心

Z=高阻抗

海纳电子资讯网:www.fpga-arm.com 为您提供各种IC中文资料

## 74HC573

#### 最大值范围:

符号	参数	值	单位
$V_{CC}$	DC 供电电压(参考 GND)	-0.5~+7.0	V
$V_{\rm IN}$	DC 输入电压(参考 GND)	-1.5~VCC+1.5	V
$V_{OUT}$	DC 输出电压(参考 GND)	-0.5~VCC+0.5	V
$I_{IN}$	每一个 PIN 的 DC 输入电流	20	mA
$I_{OUT}$	每一个 PIN 的 DC 输出电流	35	mA
$I_{CC}$	DC 供电电流,V <sub>CC</sub> 和 GND 之间	75	mA
$P_{\mathrm{D}}$	在自然环境下,PDIP和 SOIC 封装下的	750	mW
	功耗	500	
Tstg	存储温度	-65~+150	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
$T_{ m L}$	引线温度,10秒(PDIP,SOIC)	260	$^{\circ}\!\mathbb{C}$

\*最大值范围是指超过这个值,将损害器件。

操作最好在下面的推荐操作条件下。

+额定功率的下降——PDIP: -10mW/℃,65℃135℃

SOIC: -7 mW/°C,  $65 ^{\circ}\text{C} \sim 125 ^{\circ}\text{C}$ 

### 推荐操作条件:

符号	参数	最小	最大	单位
$V_{CC}$	DC 供电电压(参考 GND)	2.0	6.0	V
$V_{\rm IN}, V_{\rm OUT}$	DC 输入电压、输出电压(参考 GND)	0	$V_{CC}$	V
$T_{A}$	所有的装的操作温度	-55	+125	$^{\circ}\mathbb{C}$
$t_r$ , $t_f$	输入上升和下降时间 V <sub>CC</sub> =2.0V	0	1000	ns
	$V_{CC}$ =4.5 $V$	0	500	
	$V_{CC}=6.0V$	0	400	

这个器件带有保护电路,以免被高的静态电压或电场损坏。然而,对于高阻抗电路,必须要采取预防以免工作在任何高于最大值范围的条件下工作。 $V_{IN}$ 和  $V_{OUT}$  应该被约束在  $GND \leqslant (V_{IN}$ 或  $V_{OUT}) \leqslant VCC$ 。

不用的输入管腿必须连接总是连接到一个适合的逻辑电压电平(也就是 GND 或者  $V_{CC}$ )。不用的输出管腿必须悬空。

### DC 电子特性(电压是以 GND 为参考):

20 6								
符号	参数	测试条件	$V_{CC}$	条件限制			单位	
			V	25 ≤85 ≤125				
				$^{\circ}$ C $\sim$	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	$^{\circ}\! \mathbb{C}$		
				-55				
				$^{\circ}$ C				
V <sub>IH</sub>	最小高	V <sub>OUT</sub> =0.1V 或者 V <sub>CC</sub> -	2.0	1.5	1.5	1.5	V	

# 74HC573

		7411037					
	电平输	0.1V,	4.5	3.15	3.15	3.15	
	入电压	$ I_{OUT}  \leq 20uA$	6.0	4.2	4.2	4.2	
V <sub>IL</sub>	最大低	V <sub>OUT</sub> =0.1V 或者 V <sub>CC</sub> -	2.0	0.5	0.5	0.5	V
	电压输	0.1V,	4.5	1.35	1.35	1.35	
	入电压	$ I_{OUT}  \leq 20$ uA	6.0	1.8	1.8	1.8	
VOH	最大高	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> 或者 V <sub>IL</sub> ,	2.0	1.9	1.9	1.9	V
	电平输	$ I_{OUT}  \leq 20uA$	4.5	4.4	4.4	4.4	1
	出电压		6.0	5.9	5.9	5.9	· ·
	,	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> 或者 V <sub>IL</sub> ,					
		$ I_{OUT}  \leq 6.0 \text{mA}$	4.5	3.98	3.84	3.7	.0.
		$ I_{OUT}  \leq 7.8 \text{mA}$	6.0	5.48	5.34	5.2	
VOL	最大低	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> 或者 V <sub>IL</sub> ,	2.0	0.1	0.1	0.1	V
	电平输	$ I_{OUT}  \leq 20uA$	4.5	0.1	0.1	0.1	
	出电压		6.0	0.1	0.1	0.1	=
		V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> 或者 V <sub>IL</sub> ,			<b>A</b> .	1	
		$ I_{OUT}  \leq 6.0 \text{mA}$	4.5	0.26	0.33	0.4	
		$ I_{OUT}  \leq 7.8 \text{mA}$	6.0	0.26	0.37	0.4	
IIN	最大输	V <sub>IN</sub> =V <sub>CC</sub> 或者 GND	6.0	€0.1	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	uA
	入漏电			X			
	流		X	Ť			
IOZ	最大三	高阻抗态下的输出	6.0	±0.5	±5.0	±10	uA
	态漏电	V <sub>IN</sub> =V <sub>IH</sub> 或者 V <sub>IL</sub> ,					
	流	V <sub>OUT</sub> =V <sub>CC</sub> 或者 GND					
ICC	最大静	V <sub>IN</sub> =V <sub>CC</sub> 或者GND	6.0	4.0	4.0	4.0	uA
	态供电	$I_{OUT} = 0uA$					
	电流						
	电机	L N					

## AC 电子特性(CD-sopF, 输入 tr=tf=6.0ns):

符号	参数	VCC	条件限制			单
		V	25℃~	€85	≤125	位
			-55℃	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
t <sub>PLH</sub> ,	输入D到Q,最大延迟(图1	2.0	150	190	225	ns
$t_{ m PHL}$	和 5)	4.5	30	38	45	
	, 21	6.0	26	33	38	
$t_{\rm PLH}$ ,	锁存使能到Q的最大延迟(图	2.0	160	200	240	ns
$t_{ m PHL}$	2和图 5)	4.5	32	40	48	
		6.0	27	34	41	
t <sub>PLZ</sub> ,	输出使能到 Q 的最大延迟(图	2.0	150	190	225	ns
$t_{\mathrm{PHZ}}$	3和图 6)	4.5	30	48	45	
. 112		6.0	26	33	38	

# 74HC573

t <sub>PZH</sub> ,	输出使能到 Q 最大延迟(图 3	2.0	150	190	225	ns
$t_{\mathrm{PZL}}$	和图 6)	4.5	30	48	45	
	, ,	6.0	26	33	38	
t <sub>TLH</sub> ,	任何输出的最大输出延迟(图	2.0	60	75	90	ns
$t_{\mathrm{THL}}$	1和图5)	4.5	12	15	18	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6.0	10	13	15	
$C_{IN}$	最大输入电容	_	10	10	10	pF
C <sub>OUT</sub>	最大三态输出电容(在高阻态	_	15	15	15	pF
	下的输出)					
$C_{PD}$	功耗电容(使能所有输出)	典型在	Ē 25℃, V	CC=5V 🖇	条件下	рF
	用于确定没有负载时的动态功	23				

# 时序要求(C<sub>L</sub>=50pF,输入t<sub>r</sub>=t<sub>f</sub>=6.0 ns):

	14 (OF OE) Way 4 W					
符号	参数	VCC	限制条件			单
		V	25℃~-	<b>≤</b> 85	≤125	位
			55℃	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	$^{\circ}$ C	
$t_{SU}$	输入D到锁存使能最小建立时	2.0	50	65	75	ns
	间(图4)	4.5	10	13	15	
		6.0	9	11	13	
$t_h$	锁存使能到输入D最小保持时	2.0	5	5	5	ns
	间(图4)	4.5	5	5	5	
		<b>6</b> .0	5	5	5	
$t_{\mathrm{W}}$	锁存使能的最小脉宽(图》)	2.0	75	95	110	ns
		4.5	15	19	22	
		6.0	13	16	19	
$t_r$ , $t_f$	最大输入上升沿和下降沿时序	2.0	1000	1000	1000	ns
	(图1)	4.5	500	500	500	
		6.0	400	400	400	

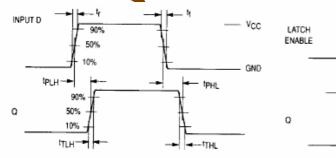


Figure 1. Switching Waveforms

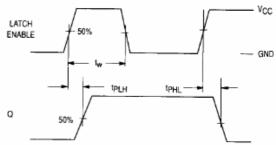
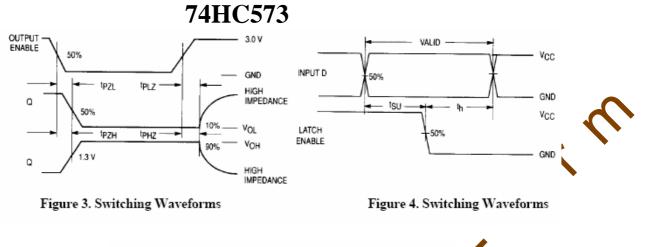
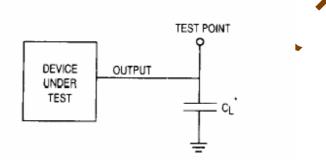


Figure 2. Switching Waveforms





\* Includes all probe and jig capacitance

Figure 5. Test Circuit

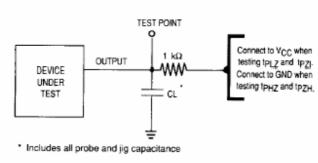


Figure 6. Test Circuit

逻辑图:

